

关键指标

频率：6~18GHz
增益：29dB
噪声系数：1.6dB
1dB 压缩点输出功率：12.5dBm
电压/电流：+5V/52mA
芯片尺寸：2mm×0.9mm×0.1mm

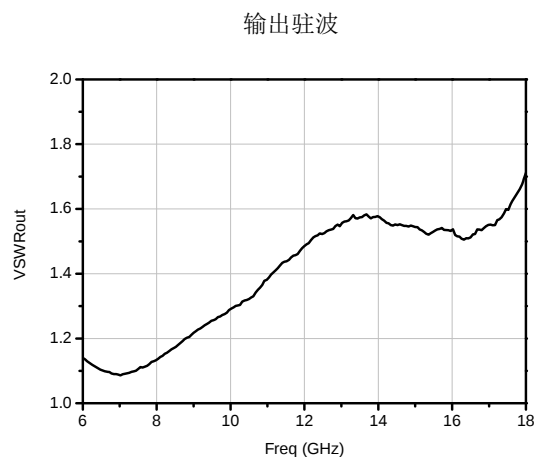
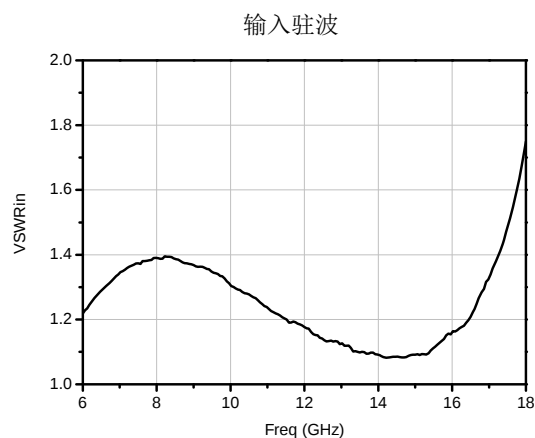
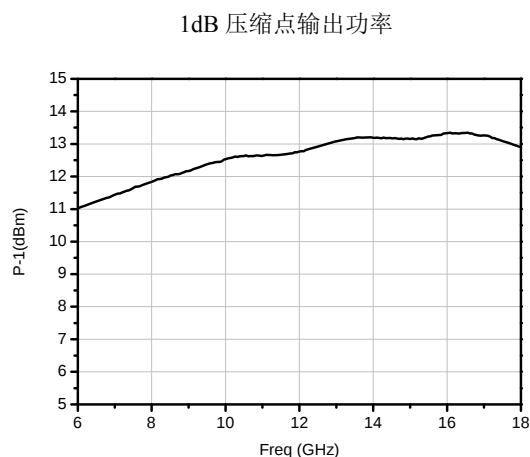
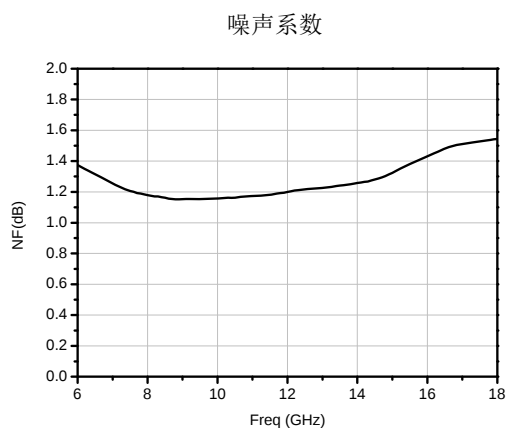
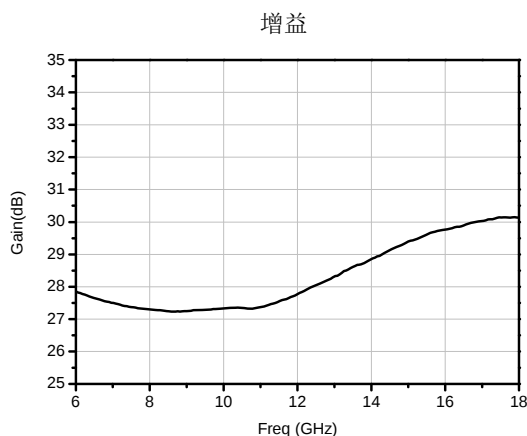
产品简介

HG116F-6 是一款 6~18 GHz 低噪声放大器芯片，增益为 29dB，1dB 压缩点输出功率为 12.5dBm，噪声系数为 1.6dB。

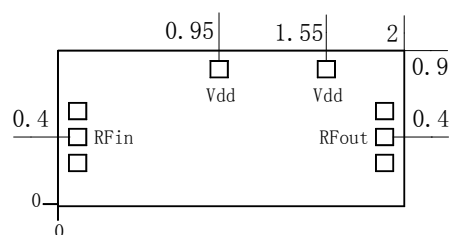
电性能 (T_A=25°C, V_{dd}=+5V)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	6~18		
增益(dB)	—	29	—
增益平坦度(dB)	—	±1.4	—
输入驻波	—	1.4	—
输出驻波	—	1.4	—
噪声系数(dB)	—	1.6	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	12.5	—
静态电流 (mA)	—	52	—

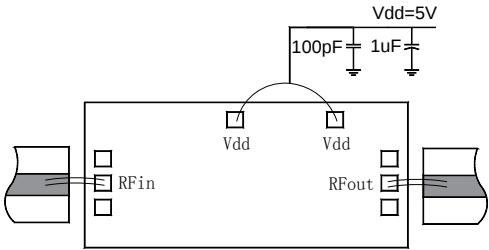
典型测试曲线



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55℃～125℃
存储温度	-65℃～150℃

注意事项

- 1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
- 2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
- 3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
- 4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250～400μm；
- 5. 芯片微波端有隔直电容；
- 6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。